

Elettronica Digitale

A.A. 2020-2021

Lezione 31/03/2021

Transistore MOS – Circuiti equivalenti per ampi segnali semplificati

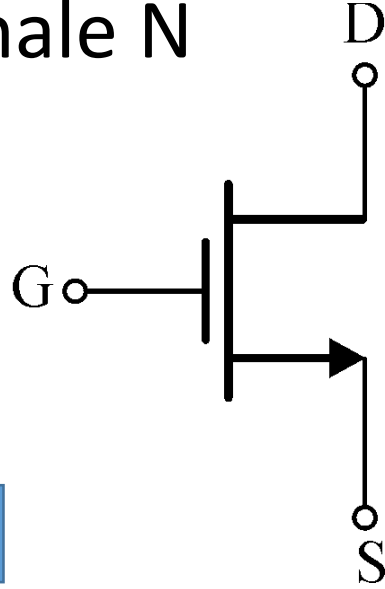
$$V_T > 0$$

$$V_{GS} \geq V_T$$

$$I_G = 0$$

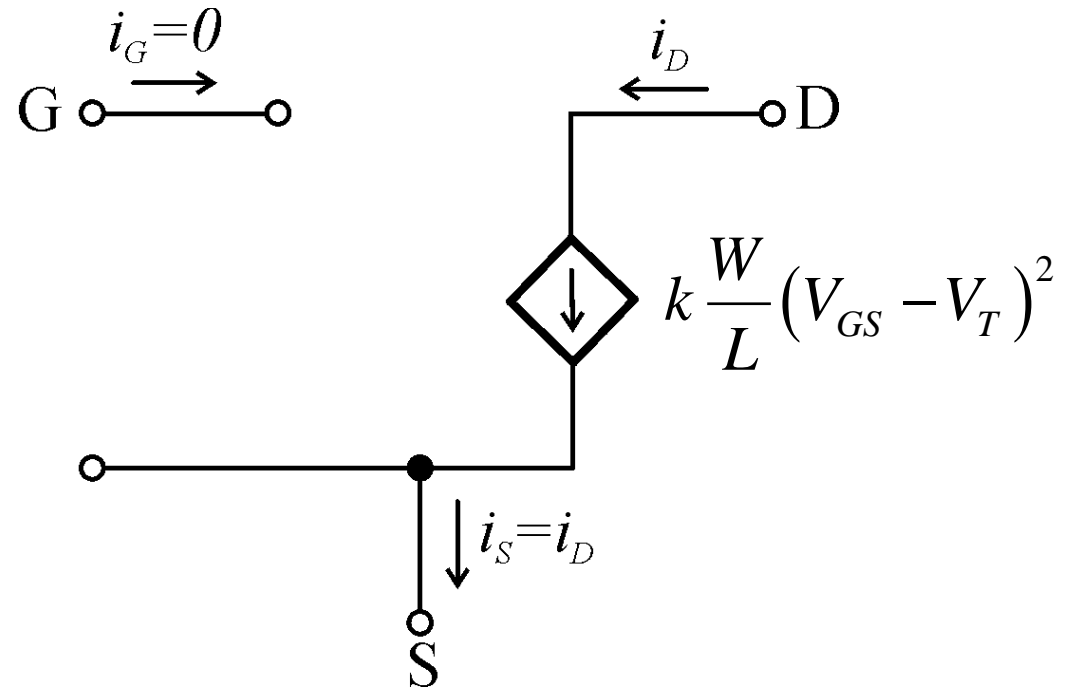
TRIODO

Canale N



$$I_{DS} = \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

SATURAZIONE



Transistore MOS – Circuiti equivalenti per ampi segnali semplificati

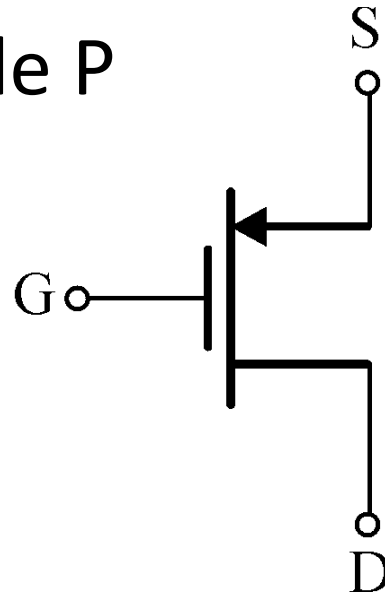
$$V_T < 0$$

Canale P

$$V_{GS} \leq V_T$$

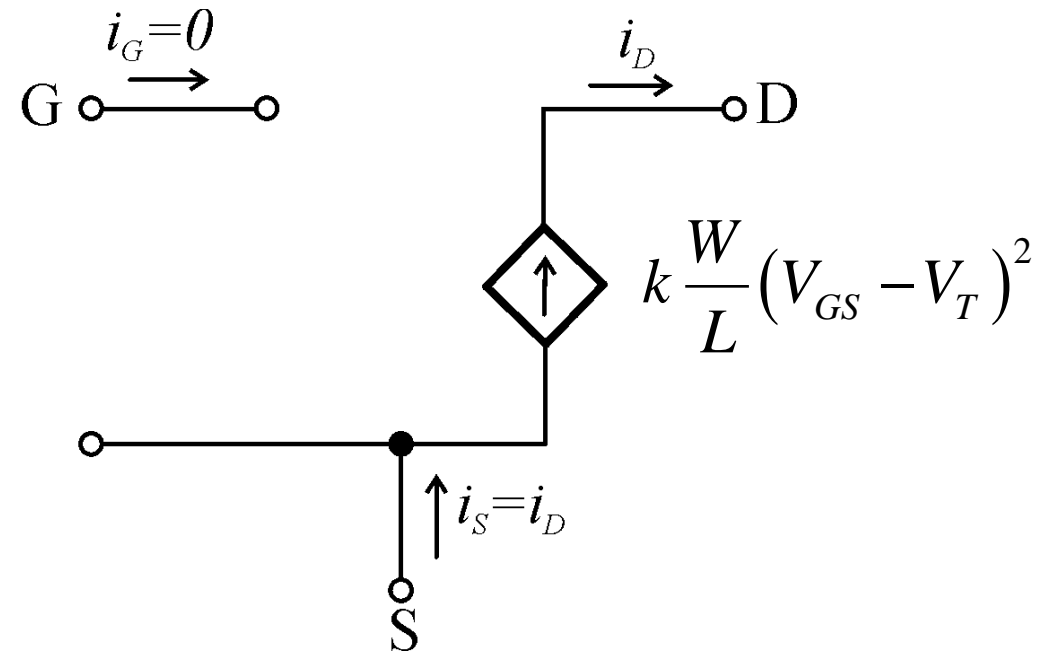
$$I_G = 0$$

TRIODO



SATURAZIONE

$$I_{SD} = \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{V_{DS}^2}{2} \right]$$

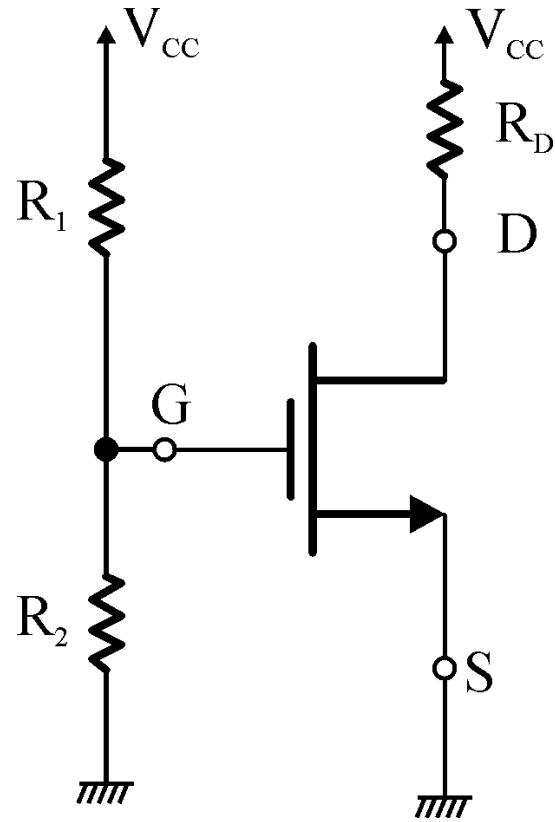


Transistore MOS– Circuiti equivalenti per ampi segnali semplificati

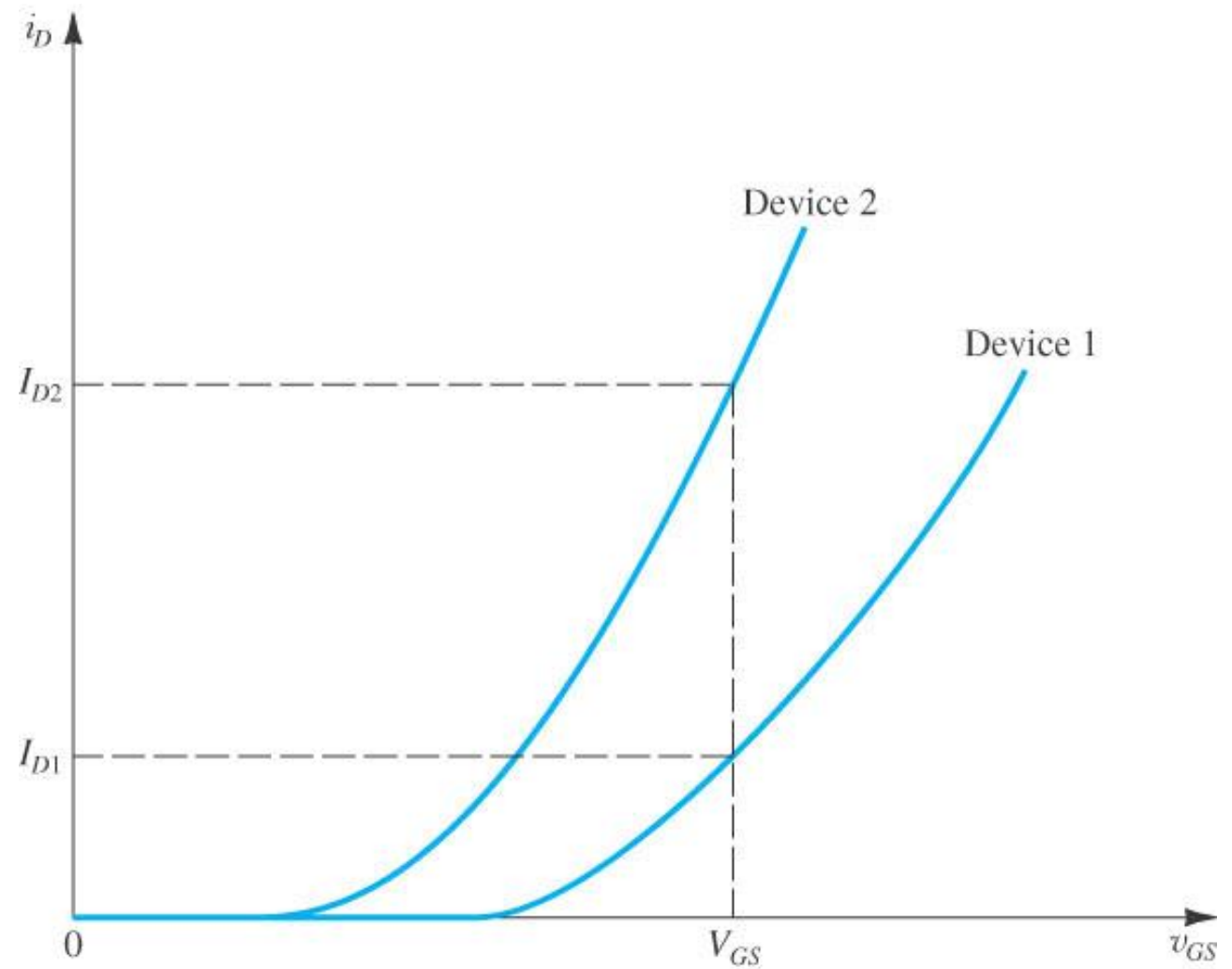
IPOTESI	VERIFICA NMOS	VERIFICA PMOS
SATURAZIONE	$V_{GS} \geq V_T$ $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T$	$V_{GS} \leq V_T$ $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$
TRIODO	$V_{GS} \geq V_T$ $V_{DS} < V_{GS} - V_T$	$V_{GS} \leq V_T$ $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

Transistore MOS– Polarizzazione in circuiti discreti

Polarizzazione a V_{GS} fissa

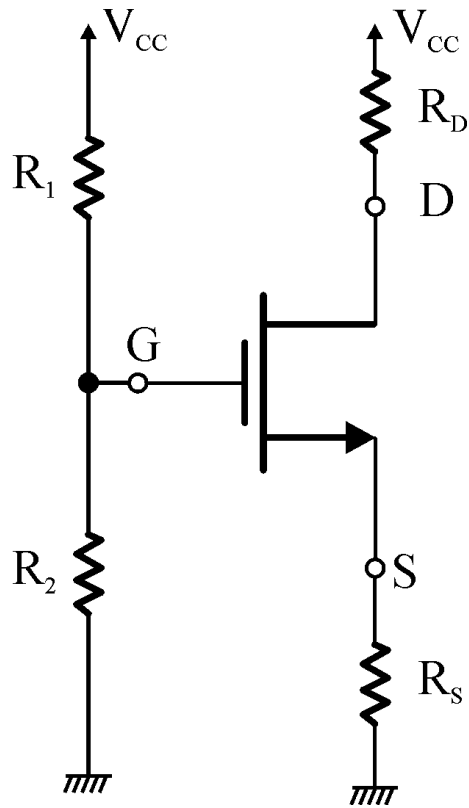


$$V_{GS} = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



Transistore MOS– Polarizzazione in circuiti discreti

Polarizzazione fissando V_G e connettendo un resistore al terminale di source



$$V_G = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_G = V_{GS} + R_S I_D$$

$$I_D = k \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

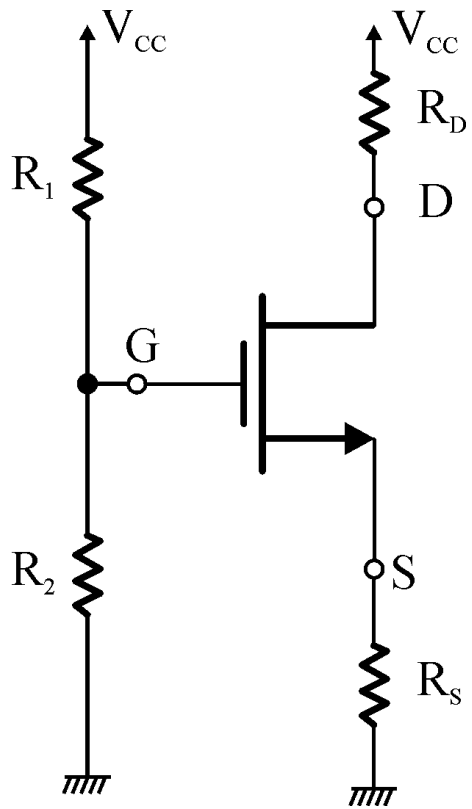


$$V_G = V_{GS} + R_S k \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

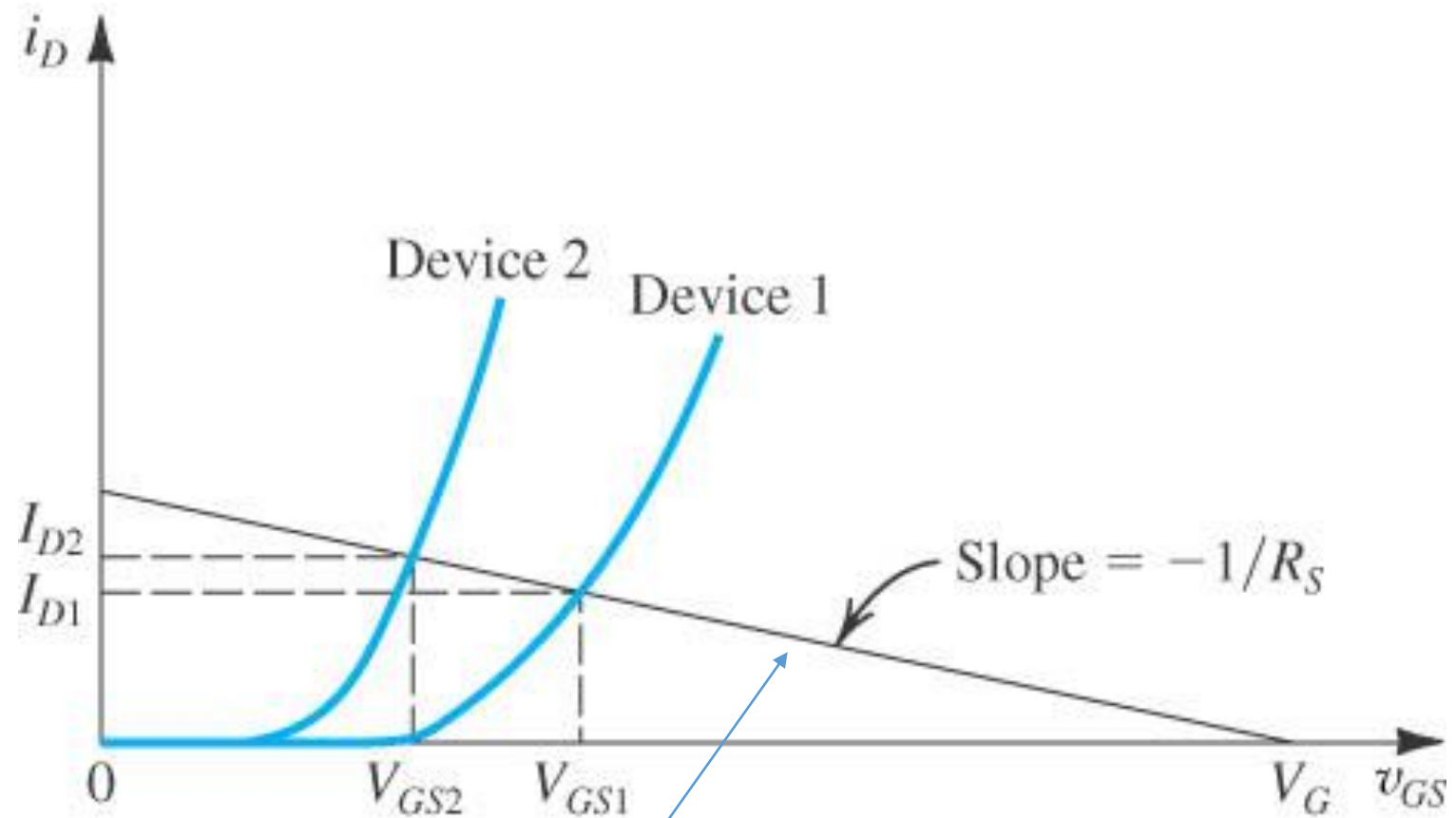
Equazione di secondo grado con due soluzioni di cui solo una accettabile

Transistore MOS– Polarizzazione in circuiti discreti

Polarizzazione fissando V_G e connettendo un resistore al terminale di source



$$V_G = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

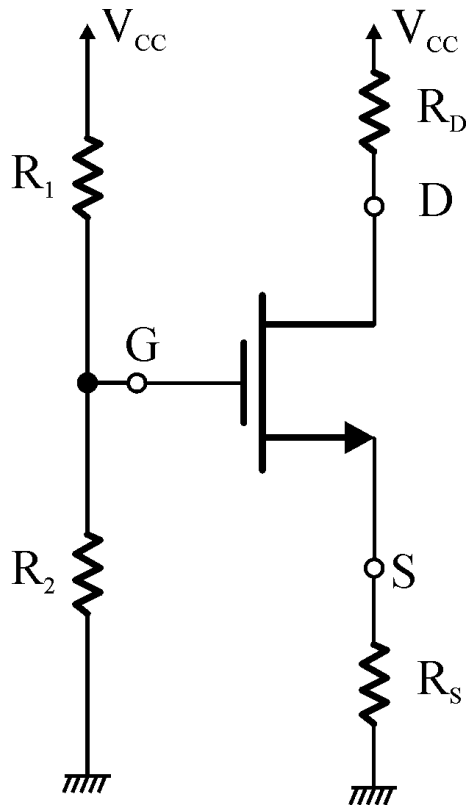


$$V_G = V_{GS} + R_S I_D$$

$$I_D = k \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

Transistore MOS– Polarizzazione in circuiti discreti

Polarizzazione fissando V_G e connettendo un resistore al terminale di source



$$V_G = V_{CC} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad V_G = V_{GS} + R_S I_D \quad I_D = k \frac{W}{L} (V_{GS} - V_T)^2$$

I_D aumenta $\rightarrow V_S$ aumenta $\rightarrow V_{GS}$ diminuisce poiché V_G è mantenuta costante dal partitore di tensione R_1, R_2
 $\rightarrow I_D$ diminuisce

R_S introduce un effetto di retroazione negativa che stabilizza la corrente di polarizzazione. La resistenza R_S prende il nome di resistenza di degenerazione

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

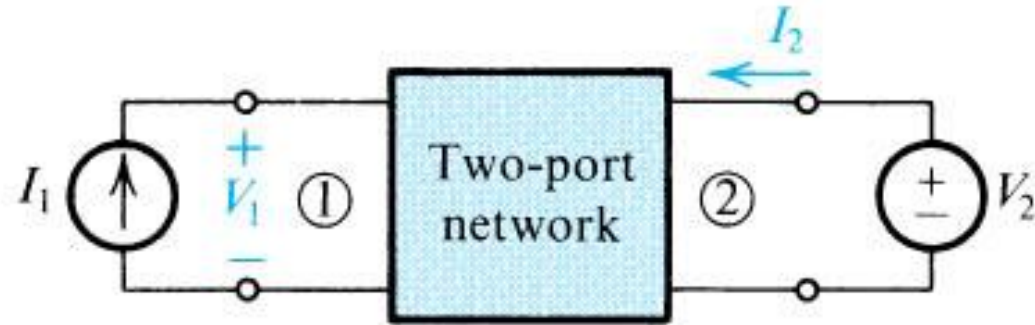


$$\begin{cases} v_1 = f(i_1, v_2) \\ i_2 = g(i_1, v_2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2 \\ i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2 \end{cases}$$

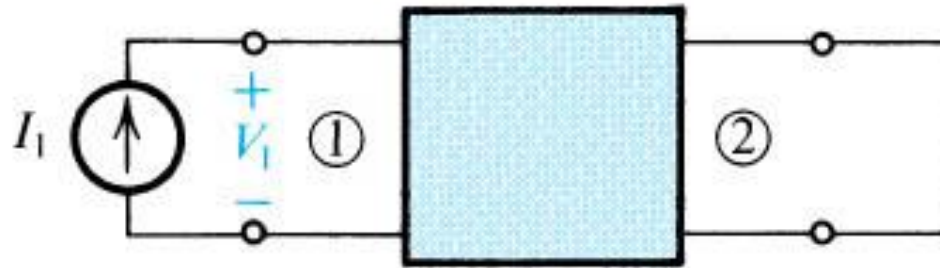
Modello a parametri ibridi (H)

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali



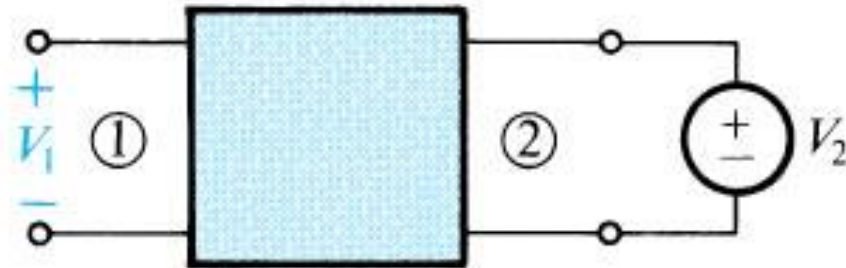
$$\begin{cases} v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2 \\ i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2 \end{cases}$$

$$h_{11} = h_i = \left. \frac{v_1}{i_1} \right|_{v_2=0}$$



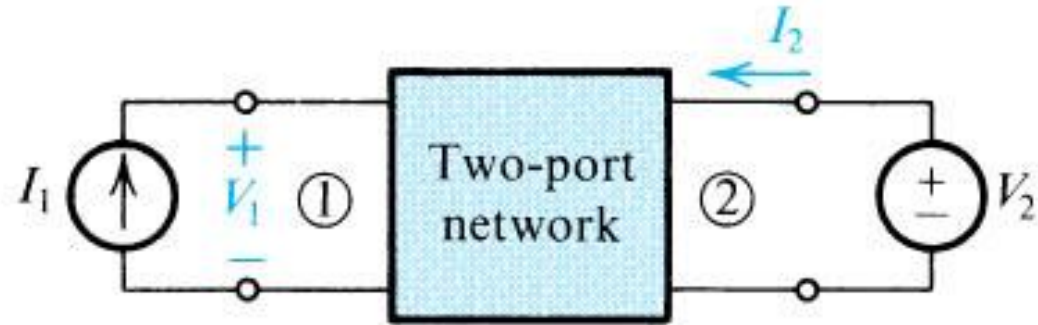
Impedenza di ingresso
(input) in cortocircuito

$$h_{12} = h_r = \left. \frac{v_1}{v_2} \right|_{i_1=0}$$



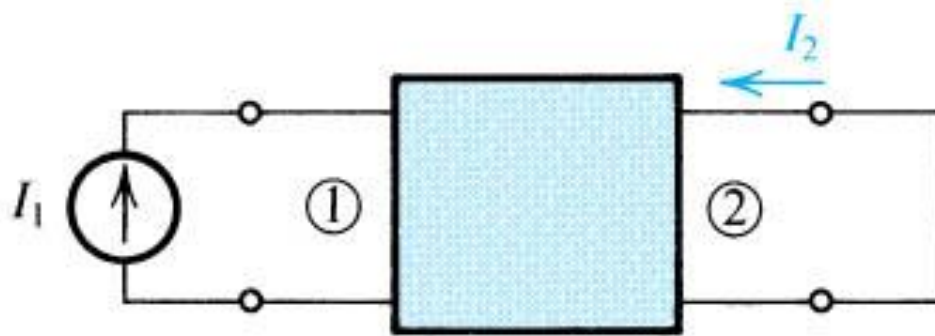
Guadagno di tensione
inverso (reverse) a
circuito aperto

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali



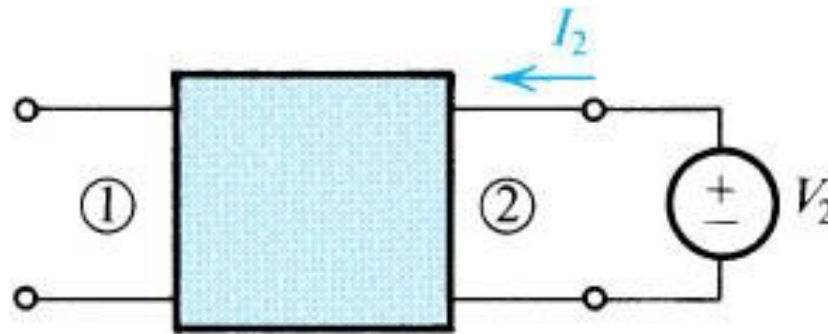
$$\begin{cases} v_1 = h_{11}i_1 + h_{12}v_2 \\ i_2 = h_{21}i_1 + h_{22}v_2 \end{cases}$$

$$h_{21} = h_f = \left. \frac{i_2}{i_1} \right|_{v_2=0}$$



Guadagno di corrente diretto (forward) in cortocircuito

$$h_{22} = h_o = \left. \frac{i_2}{v_2} \right|_{i_1=0}$$



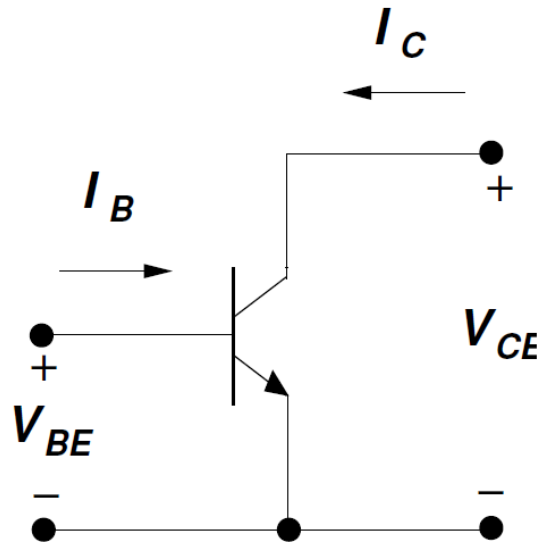
Ammettenza di uscita (output) a circuito aperto

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali



$$\begin{cases} v_1 = h_i i_1 + h_r v_2 \\ i_2 = h_f i_1 + h_o v_2 \end{cases}$$

Configurazione a emettitore comune

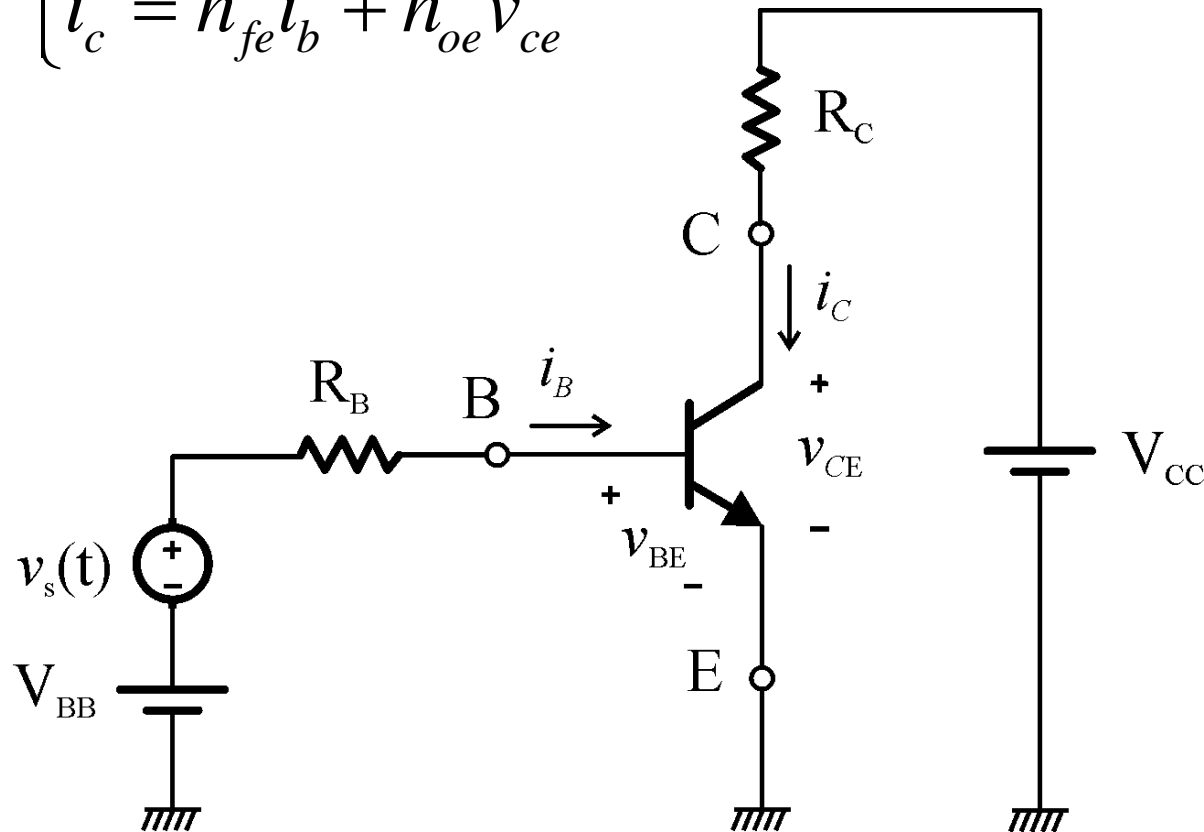


$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

Configurazione a emettitore comune

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$



$$\begin{cases} v_{BE} = f(i_B, v_{CE}) \\ i_C = g(i_B, v_{CE}) \end{cases}$$

$$v_{BE}(t) \triangleq V_{BEQ} + v_{be}(t)$$

$$i_B(t) \triangleq I_{BQ} + i_b(t)$$

$$v_{CE}(t) \triangleq V_{CEQ} + v_{ce}(t)$$

$$i_C(t) \triangleq I_{CQ} + i_c(t)$$

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{BE}(t) = V_{BEQ} + v_{be}(t) = f(I_{BQ} + i_b(t), V_{CEQ} + v_{ce}(t)) \\ i_C(t) = I_{CQ} + i_c(t) = g(I_{BQ} + i_b(t), V_{CEQ} + v_{ce}(t)) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{BE}(t) = \cancel{V_{BEQ}} + v_{be}(t) = f(\cancel{I_{BQ}}, \cancel{V_{CEQ}}) + \left. \frac{\partial f}{\partial i_B} \right|_Q i_b(t) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_{CE}} \right|_Q v_{ce}(t) + \dots \\ i_C(t) = \cancel{I_{CQ}} + i_c(t) = g(\cancel{I_{BQ}}, \cancel{V_{CEQ}}) + \left. \frac{\partial g}{\partial i_B} \right|_Q i_b(t) + \left. \frac{\partial g}{\partial v_{CE}} \right|_Q v_{ce}(t) + \dots \end{cases}$$



$$\begin{cases} v_{be}(t) \approx + \left. \frac{\partial f}{\partial i_B} \right|_Q i_b(t) + \left. \frac{\partial f}{\partial v_{CE}} \right|_Q v_{ce}(t) \\ i_c(t) \approx + \left. \frac{\partial g}{\partial i_B} \right|_Q i_b(t) + \left. \frac{\partial g}{\partial v_{CE}} \right|_Q v_{ce}(t) \end{cases}$$

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{be}(t) \approx + \frac{\partial f}{\partial i_B} \Big|_Q i_b(t) + \frac{\partial f}{\partial v_{CE}} \Big|_Q v_{ce}(t) \\ i_c(t) \approx + \frac{\partial g}{\partial i_B} \Big|_Q i_b(t) + \frac{\partial g}{\partial v_{CE}} \Big|_Q v_{ce}(t) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{BE} = f(i_B, v_{CE}) \\ i_C = g(i_B, v_{CE}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

$$h_{ie} = \frac{\partial f}{\partial i_B} \Big|_Q = \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \Big|_Q$$

$$h_{re} = \frac{\partial f}{\partial v_{CE}} \Big|_Q = \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \Big|_Q$$

$$h_{fe} = \frac{\partial g}{\partial i_B} \Big|_Q = \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \Big|_Q$$

$$h_{oe} = \frac{\partial g}{\partial v_{CE}} \Big|_Q = \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \Big|_Q$$

Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

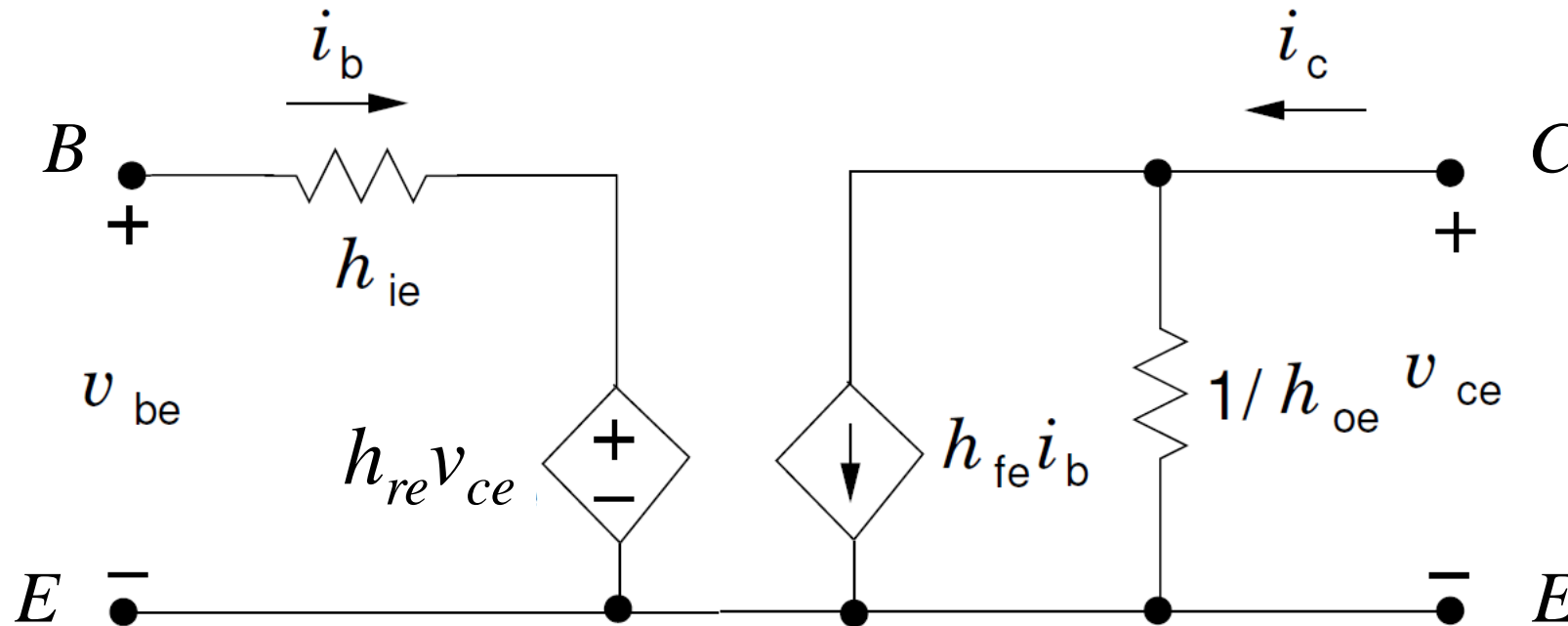
$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q$$

$$h_{re} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_Q$$

$$h_{fe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial i_B} \right|_Q$$

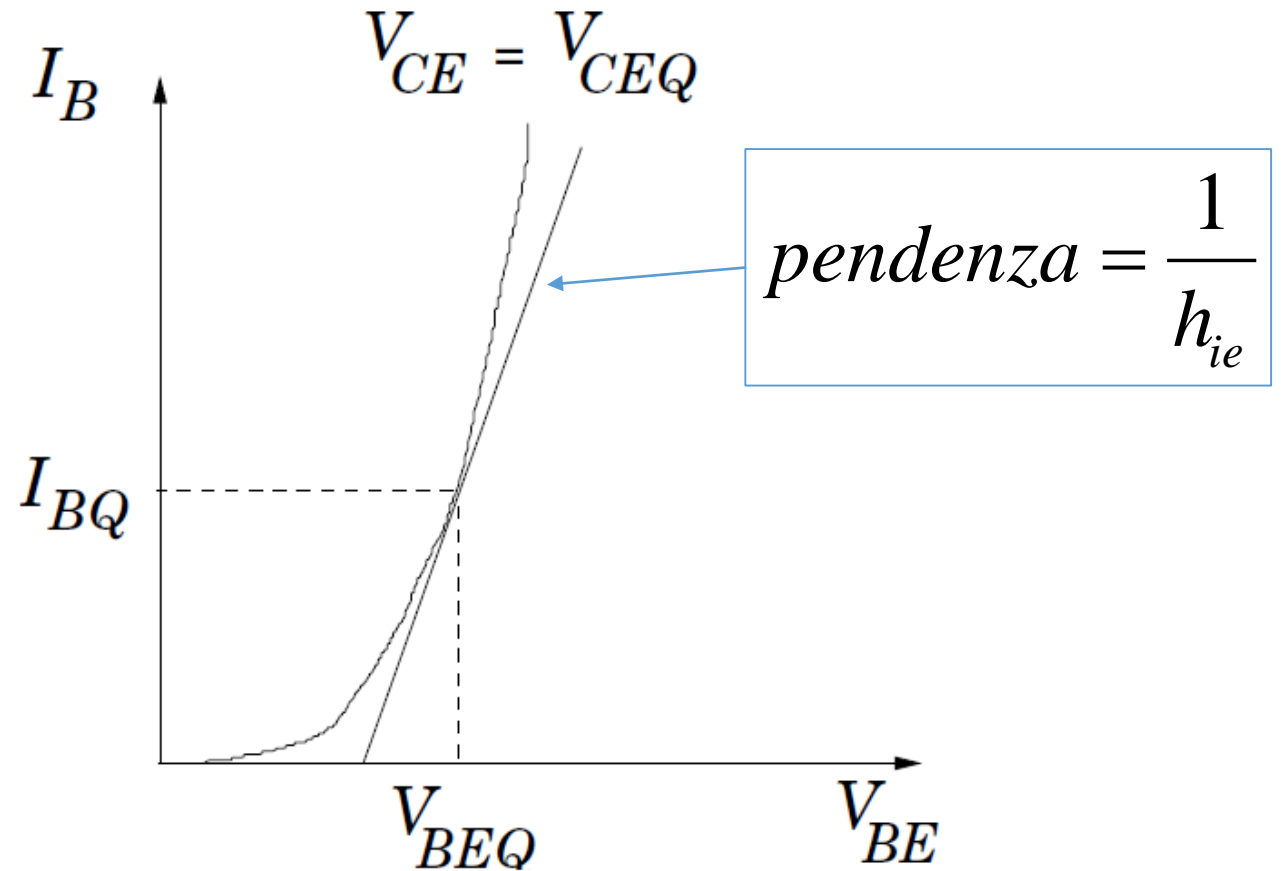
$$h_{oe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_Q$$



Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

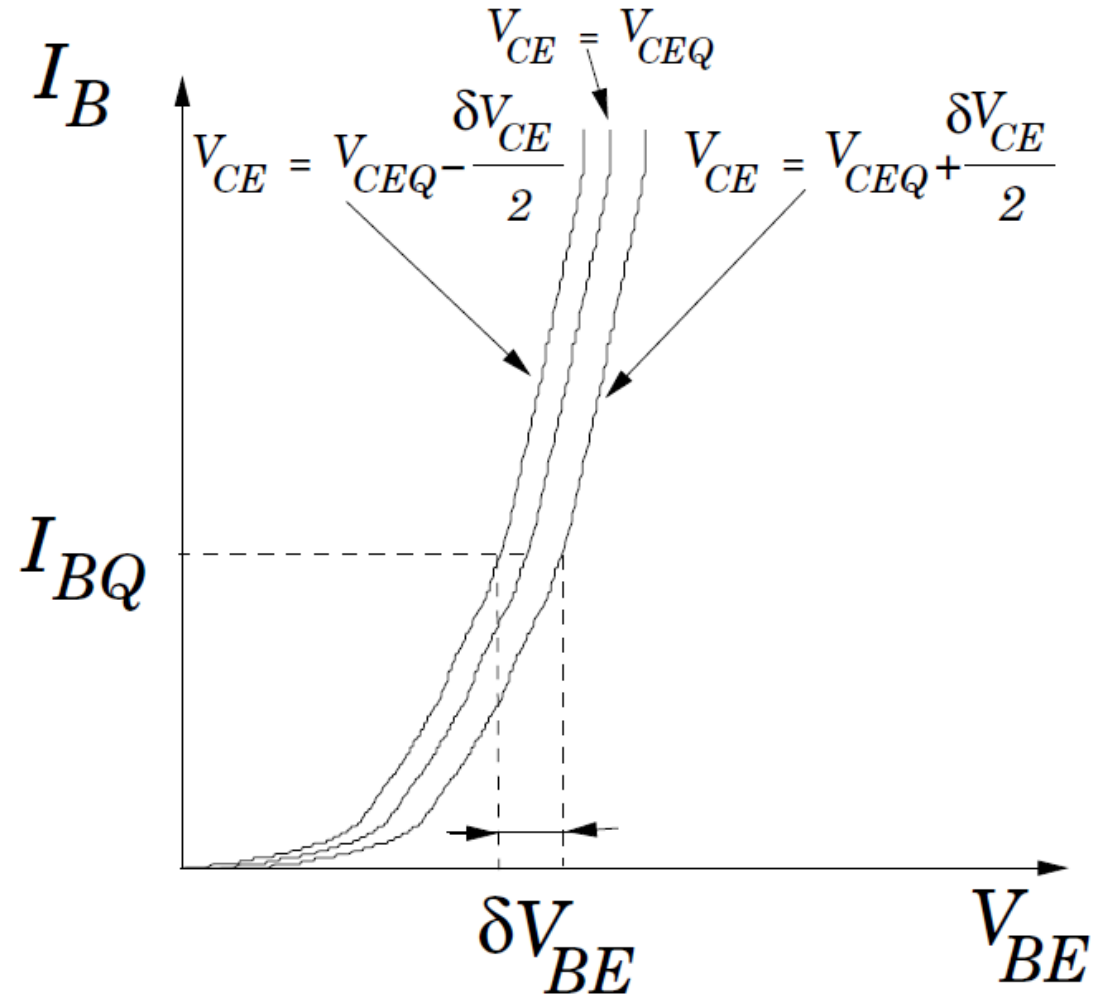
$$h_{ie} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial i_B} \right|_Q$$



Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

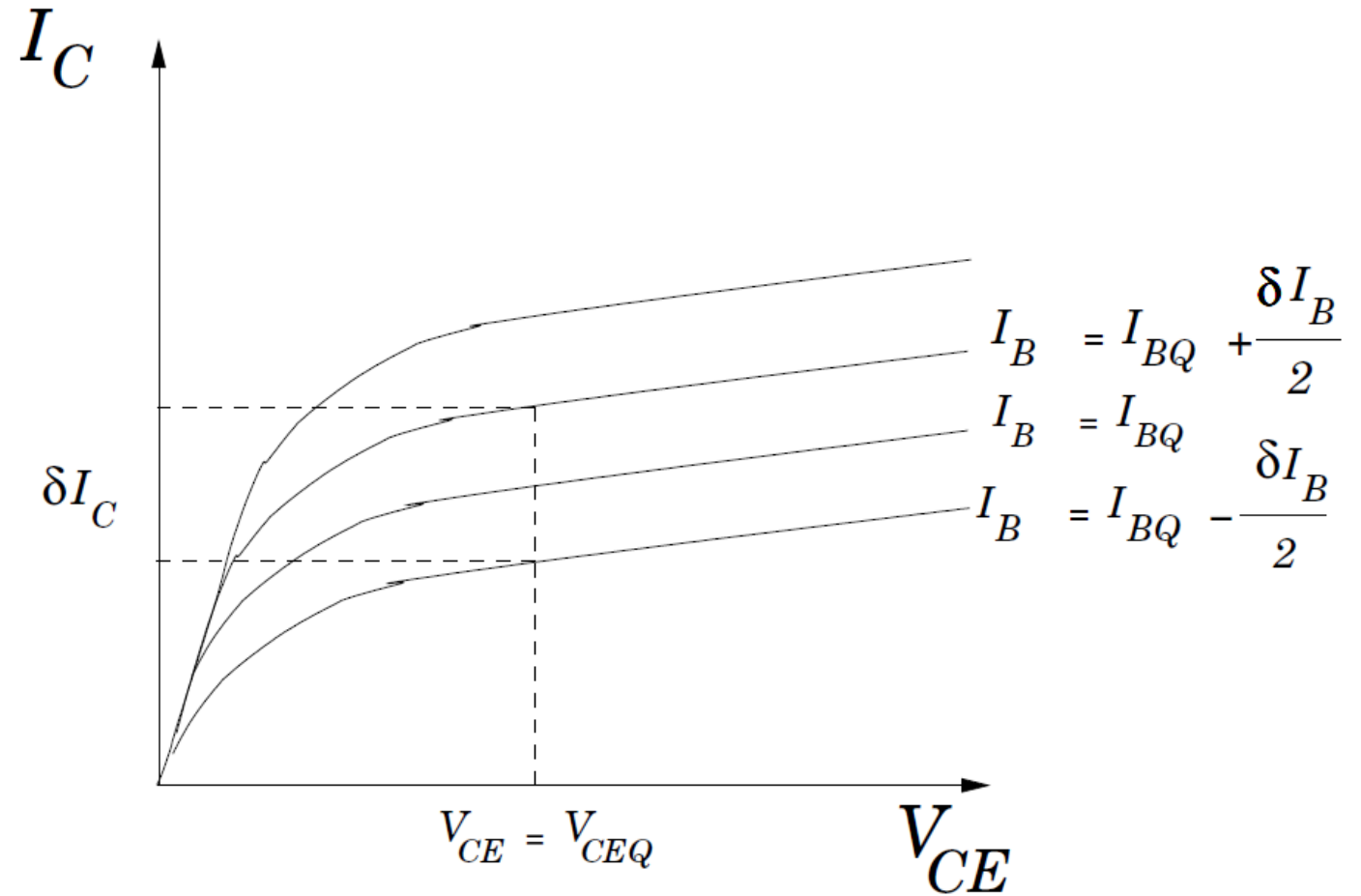
$$h_{re} = \left. \frac{\partial v_{BE}}{\partial v_{CE}} \right|_Q = \lim_{\delta v_{CE} \rightarrow 0} \left. \frac{\delta v_{BE}}{\delta v_{CE}} \right|_{i_B = I_{BQ}}$$



Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

$$h_{fe} = \left. \frac{\partial i_c}{\partial i_B} \right|_Q = \lim_{\delta i_B \rightarrow 0} \left. \frac{\delta i_c}{\delta i_B} \right|_{v_{CE}=V_{CEQ}}$$



Transistore BJT– Modello linearizzato per piccoli segnali

$$\begin{cases} v_{be} = h_{ie} i_b + h_{re} v_{ce} \\ i_c = h_{fe} i_b + h_{oe} v_{ce} \end{cases}$$

$$h_{oe} = \left. \frac{\partial i_C}{\partial v_{CE}} \right|_Q = \lim_{\delta v_{CE} \rightarrow 0} \left. \frac{\delta i_C}{\delta v_{CE}} \right|_{i_B = I_{BQ}}$$

